科学研究費助成事業

研究成果報告書



平成 26 年 4月 22 日現在

機関番号: 14301
研究種目: 挑戦的萌芽研究
研究期間: 2012~2013
課題番号: 2 4 6 5 6 0 8 7
研究課題名(和文)顕微ラマン分光を用いたMEMS共振構造体の時間分解局所応力測定
研究課題名(英文)Time-resolved local-stress measurement of MEMS resonating structure using micro Rama n spectroscopy
研究代表者
土屋 智由 (Tsuchiya, Toshiyuki)
京都大学・工学(系)研究科(研究院)・准教授
研究者番号:60378792
交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,100,000 円、(間接経費) 930,000 円

研究成果の概要(和文):振動によって周期変化するシリコン製のMEMS構造体振動子の局所応力を計測するための時間 分解顕微ラマン分光を実現することを目的として、プルインを用いた静電駆動MEMSチョッパーを提案,試作,評価した .静電駆動アクチュエータの可動部のおもりにスリットを形成し、ガラス基板上のシャッターと組み合わせて,駆動に よりON/OFFを切り替える.このデバイスを市販の顕微ラマン分光装置の入射光学系に挿入し、ラマン分光の励起光を時 間変調させ,振動子の駆動と同期させることで応力をストロボスコピックに時間分解を実現する.試作した両側駆動チ ョッパの切り替え時間は50µ秒以下であり,応用可能であることを示した.

研究成果の概要(英文): A pull-in type electrostatic optical chopper using silicon-on-glass (SOG) wafer was proposed, fabricated, and tested to develop time-resolved micro-Raman spectroscopy for measuring local d ynamic stress of silicon micro-electro-mechanical system (MEMS) resonators. The moving mass of electrostat ic actuator made of the silicon device layer of SOG wafer is used as an optical chopper. The silicon mass has many slits where the incident laser light penetrates. At the OFF-state, the penetrated light terminate d at aluminum shields on the glass substrate. By actuating the mass by electrostatic parallel plate electro odes, the penetrated light goes through the chopper (ON-state). Inserting the chopper to the micro Raman s pectroscope, time-resolved analysis will be realized. The mechanical and optical responses of the chopper were measured. The double-side-drive type of chopper has a response time of around 50 us, which is good en ough for the application.

研究分野:工学

科研費の分科・細目:機械工学・機械材料・材料力学

キーワード:動的局所応力計測 シリコン 顕微ラマン分光 光チョッパー 静電アクチュエータ 振動子

1.研究開始当初の背景

単結晶シリコンを機械構造体として用いる MEMS デバイスは加速度、角速度センサな ど力学量センサや光ディスプレイ、光通信 システムなどにおける小型ミラーデバイス など様々な分野で実用化が進んでいる。し かしながら、単結晶シリコンは脆性材料で あり、長期信頼性を保証する上で微細構造 に加わるひずみ、応力の評価は重要である。 微小な構造体に加わる応力を直接測定する ことは困難であるので、従来は有限要素法 などによる数値計算による応力評価が広く 用いられている。しかしながら、数値計算 手法では局所応力の評価は応力集中の評価 が困難であり、実測による評価も数値計算 による評価の妥当性を確認するためには重 要である。単結晶シリコンの数ミクロン領 域の応力場を測定する手法として、顕微ラ マン分光が広く用いられている。酸化、拡 散プロセスによって導入されるひずみの評 価は、信頼性、デバイス特性の評価に重要 な役割を果たしている。MEMS 分野におい ても単軸引張試験におけるひずみ測定手法 の一つとして顕微ラマン分光を用いること が提案されている。しかし、これらは静的 あるいは準静的な応力の測定であり、実用 のデバイスで印加される動的な(振動)応 力場の測定はラマン分光の測定時間から考 えると困難であった。近年、10 kHz 以上で 振動する MEMS 構造体に対するラマン分 光測定が提案者などから報告されている。 これらは、振動周期に対して測定が遅いた め、応力に比例したスペクトルの変位とし てはなく、その時間積分の結果として、ス ペクトルの広がりとして観測されている。 この手法によっても、ある程度の定量性を もって応力場を計測することは可能である がスペクトルの広がりを解析するのが複雑 であり、瞬間的な応力を測定できることが 望まれる。

2.研究の目的

本研究では MEMS (微小電気機械システム) で用いられる微細な単結晶シリコンの機械 構造体に印加される応力を動的にかつ局所 的に計測、評価する手法を開発することを目 的とする。具体的は振動する単結晶シリコン MEMS デバイスの支持梁の応力を顕微ラマ ン分光で測定する。このときに励起光を顕微ラマ ン分光で測定する。このときに励起光を振動 変位に同期させて変調し、ストロボ顕微鏡と 同様の手法で特定の位相におけるラマン散 乱光を観察し、動的に変化する応力場を時間 領域で観察しようというものである。さらに、 本研究の特徴として、レーザー励起光の変調 を、光 MEMS デバイスすなわち微小なミラー あるいはチョッパで行うことを提案する。

3.研究の方法

(1) 時間分解顕微ラマン分光システムの構成 本研究で提案する時間分解計測システムの

概要を Fig. 1 に示す.市販の顕微ラマン分光 装置(堀場製作所,LabRAM HR-800)の入射 光学系にチョッパを挿入し,MEMS 振動子の 駆動信号に同期させたパルス状の駆動信号 を供給する.チョッパの駆動により,振動子 の任意の位相に同期したパルス状の励起光 を照射し,発生するラマン散乱光を分光する ことで,その位相における応力を計測するこ とが可能となる.本研究では,周波数1 kHz 程度の MEMS 振動子を対象として,チョッピ ングのパルス幅として100 μsを実現するデバ イスを開発する.



Fig.1. Time-resolved micro Raman spectroscopy



Fig. 2. Schematics and operation principles

(2) MEMS 光チョッパ:上記の仕様に基づい て考案したチョッパのデバイス構造を Fig. 2 に示す.これはラマン分光器の入射光学系に 設置されたフィルタなどを挿入する治具に 取り付けることを意図している.チップサイ ズは3 mm 角とした. 取付位置での光径は約 250 μm であるのでチョッパの直径を 500 μm と設定した.透明なガラス基板上にシリコン 層(厚さ 15 μm)を接合した Silicon on glass (SOG)ウエハを用いる シリコンの構造は Fig. 2右のようにチョッパ部は3 µm幅のスリット を多数形成したシリコン板であり,これらを 4 本の梁で支持している(黒い部分が基板に 固定されている). チョッパは左右の斜めに 配置した並行平板電極で固定電極に電圧を 印加して駆動した.プルイン動作させること で高速駆動するが,電極でプルインしないよ うにストッパを形成している.設計変位は3 μm である.ガラス基板側には後述するセル フアライメントプロセスで板の開口部に一 致した位置に Al の遮光膜があり, チョッパ の駆動原点では光が透過せず(OFF),電圧を 印加して変位すると隙間から光が透過する (ON).

(3) 作製プロセス: Silicon on Insulator (SOI)と ガラス基板を陽極接合し, SOI の支持基板と 埋め込み酸化膜を除去して得られた SOG 基 板を用いてデバイスを作製した.プロセスフ ローを Fig. 3 に示す.犠牲層エッチングは気 相フッ酸を用いて,付着を防止した.リリー ス後にアルミを全面に EB 蒸着した.Si 上に 形成した膜は配線用の電極として利用し,ス リットを通してガラス基板上に形成した膜 は遮光膜となる.



Fig. 3. Fabrication process

4 . 研究成果

(1) 片側駆動型 MEMS 光チョッパ: 試作した デバイスを Fig. 4 に示す.全面にアルミを蒸 着しているので全体が銀色に見える.駆動に よる変位を左図に示した.DC 電圧駆動では 25V 程度の電圧でプルイン,リリースを繰り 返すことが可能であった.



Fig. 4. Fabricated chopper device

この構造に対して変位をストロボスコピック顕微計測システム(Polytec, MSA-500)で 測定し,また,実際に顕微ラマン分光装置に 組み込み,試料位置にフォトダイオードを設 置してその出力を測定して光量の測定を試 みた

Fig. 5a は時間0で24Vを印加した時のプルイン時の変位, Fig. 5b はプルイン直前の変位 0.72 µm に駆動して,時間0で電圧をOFF にしたときの変位である.実際には矩形波で繰り返し駆動して,ある時間遅れでの画像をパターンマッチングで変位を計測している. ON(プルイン時)の応答速度は50µs 程度で, 目標の応答速度を得られたが,OFF 時には変位0の付近で振動し,静定までに1~2 msかかる応答を得た.OFF 時はばねの復元力でつ り合い位置に戻る動作で,ストッパ等がないために減衰振動が発生している.



Fig. 5. Step response

このことは試料位置での光量測定の結果 (Fig. 6)からも確認された.周期1.2 ms,デュ ーティ比10%の駆動パルスに対して,最初の 応答のパルス幅はそれとほぼ同等で立ち上 がり,立下りも十分な速さであるが,減衰振 動に対応した透過光があり,このままでは時 間分解顕微ラマン分光に用いることができ ないとの結論に至った.また,OFF時にも ON時の30%程度の光量が透過しており,消 光比(ON/OFF時の光量比)が2.3と小さい.原 因として蒸着時にチョッパがずれてしまっ ていること,犠牲層エッチングによるガラス 表面の荒れなどが考察される.



Fig. 6. Modulated light intensity at specimen.

このデバイスで共振周波数 838 Hz の Si の片 持ち梁面外曲げ振動子の駆動による梁部の 応力の測定を試みた.パルスを発生する位相 を変化させ,シリコンのラマンスペクトルを 測定したが,位相変化に対して有意な差は見 られなかった.減衰振動を防止するようなデ バイス構造の改良と,OFF 時の漏れ光の低減 が必要である.

(2)両側駆動型 MEMS 光チョッパ:前項目で

述べた片側駆動型 MEMS 光チョッパの課題 を解決するために,新しいデバイス構造,作 製プロセスを提案する.特徴は以下の通りで ある.

●立下り時のオーバーシュートを防ぐための 両側駆動する上下対称の構造.

●ギャップをシリコン側に形成し,表面荒れが生じるガラス基板のエッチングを回避
●AIスリットのリソグラフィ加工による遮光性の向上.

提案したデバイス構造の模式図を Fig. 7 に示 す.両側駆動構造とすることによって,立下 り時においても立上り時と同様の応答が期 待できる. 両側駆動をするためには,立上 り側,立下り側それぞれに電圧を印加し,可 動部はグラウンドに接続する必要がある.そ こで立上り側,立下り側,可動部の電極パタ ーンを作製する.



Fig. 7. double-side-drive optical chopper



(f) Electrode patterning (f) Device patterning

Fig. 8. Fabrication process

さらに Si をエッチングして空洞(キャビティ) を作製することにより,ガラスエッチングに よるリリースをする必要がない構造とした. この作製プロセスの模式図を Fig.8 に示す. また,プロセス変更による利点を以下にまと める. ・従来の片側駆動型 MEMS 光チョッパはガラ

・従来の方側駆動型 MEMS エチョッハはガラ スエッチングにより可動部をリリースした. そこであらかじめ SOI デバイス層に空洞(キ ャビティ)を作製し,接合後デバイス形状をパ ターニングすることでガラスエッチングす ることなく可動部をリリースすることがで きる.

・従来のプロセスではリリース後に AI 蒸着 を行っていたため,スリットの幅は AI シャ ッターと同じであった.しかし提案するプロ セスでは,アライメント接合前に Al シャッ ターをリフトオフで作製することにより,自 由に幅を設定できる. Al シャッターをスリ ットよりわずかに大きくすることによって, スリットと Al シャッターのずれを許容でき る.また,光の回折による漏れも低減できる, といった利点が挙げられる.



Fig. 9. Fabricated double-side-drive chopper



Fig. 10. On (left) and off (right) state of the chopper.



Fig. 11. Step response of double-side-drive chopper.

このプロセスで作製したチョッパを Fig.9 に 示す.また,チョッパを駆動したときのスリ ット部の画像を Fig.10 に示した.スリット部 の開閉が適切に行われていることが確認で きている.さらに,ON,OFF 時の応答を fig.11 に示した.減衰振動の影響が非常に小さい駆 動が確認でき,応用可能であることを示した.

5.主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計0件)

〔学会発表〕(計2件)

谷山彰,小北雄亮,平井義和,田畑修,<u>土</u> <u>屋智由</u>,時間分解顕微ラマン分光のための プルイン型 MEMS 光チョッパの動作特性,日 本実験力学会 2013 年度年次講演会,由利本 荘市文化交流館,由利本荘,2013 年 8 月 20-23 日, pp. 129-131.

小北雄亮,谷山彰,平井義和,田畑修,<u>土</u> <u>屋智由</u>,時間分解顕微ラマン分光による Si 振動子の動的応力測定のための両側静電駆 動型 MEMS 光チョッパ,第30回「センサ・ マイクロマシンと応用システム」シンポジウ ム,電気学会,仙台国際センター,仙台,2013 年11月 5-7日,5PM3-PSS-013

〔図書〕(計0件)

〔産業財産権〕 ○出願状況(計0件)

○取得状況(計0件)

〔その他〕 ホームページ等 http://www.nms.me.kyoto-u.ac.jp/

 6.研究組織
(1)研究代表者
土屋 智由(TOSHIYUKI TSUCHIYA)
京都大学・大学院工学研究科・准教授 研究者番号:60378792

(2)研究分担者 なし

(3)連携研究者 なし